

БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР КТ837А/Е

Предельные параметры ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Параметр	Обозначение	КТ837А/Е	Ед. изм.
Напряжение коллектор-база	V_{CBO}	-80/-60	В
Напряжение коллектор-эмиттер	V_{CEO}	-70/-55	В
Напряжение эмиттер-база	V_{EBO}	-15/-15	В
Ток коллектора	I_C	-7.5/-7.5	А
Максимальный ток коллектора	$I_{C(\text{peak})}$	-10/-10	А
Ток базы	I_B	1/1	А
Максимальная мощность рассеяния	P_C	30/30	Вт
Температура перехода	T_J	125	$^\circ\text{C}$
Температура хранения	T_{stg}	-40 до +100	$^\circ\text{C}$

Электрические характеристики

Параметр	Обозначение	Условия измерения	КТ837А/Е			Ед. изм.
			Мин.	Тип.	Макс.	
Обратный ток коллектора	I_{CBO}	$V_{CE}=80/60 \text{ В}, I_B=0$	-	-	10/10	мА
Обратный ток эмиттера	I_{EBO}	$V_{EB}=15/15 \text{ В}, I_C=0$	-	-	0.3/0.3	мА
Статический коэфф. передачи по току	h_{FE}	$V_{CE}=5 \text{ В}, I_C=2 \text{ А}$	10/50	-	40/150	-
Напряжение насыщ. база-эмиттер	$V_{BE(sat)}$	$I_B=0.5 \text{ А}, I_C=2 \text{ А}$	-	1.1/1.1	1.5/1.5	В
Напряжение насыщ. коллектор-эмиттер	$V_{CE(sat)}$	$I_C=3 \text{ А}, I_B=370 \text{ мА}$	-	1.8/0.7	2.5/0.9	В
Предельная частота коэффициента передачи тока	f_T	$V_{CE}=10 \text{ В}, I_C=0.5 \text{ А}$ $f=1 \text{ МГц}$	4/4	-	-	МГц
Обратный ток коллектора	I_{CES}	$V_{CE}=80/60 \text{ В}, V_{EB}=0$	-	-	150/150	мкА